

News Release / Presseinformation

Infineon präsentiert CoolMOS™ C7; Technologiesprung ermöglicht weltweit niedrigsten Einschaltwiderstand in hart schaltenden Anwendungen

Neubiberg, 6. Mai 2013 – Infineon Technologies erweitert sein Produkt-Portfolio mit dem CoolMOS™ C7 und führt damit eine neue Generation der 650V Superjunction MOSFET-Technologie ein. Die C7-Produktfamilie bietet für jedes Gehäuse den marktweit geringsten Einschaltwiderstand $R_{DS(on)}$ und erhöht dank geringerer Schaltverluste den Wirkungsgrad in allen Lastbereichen. C7 ist auf den Einsatz in hart schaltenden Topologien ausgerichtet – beispielsweise Continuous Conduction Mode Power Factor Correction (CCM PFC), Two Transistor Forward (TTF) und Solar Boost. Typische Anwendungen sind Server, Solar- und Telekommunikationsanlagen und UPS-Systeme (Uninterruptible Power Supply; unterbrechungsfreie Stromversorgung). Mit einer Durchbruchspannung von 650V eignet sich die C7-Familie auch für Anwendungen, die eine größere Sicherheitsreserve erfordern.

„C7 schreibt die zwölfjährige Innovationsgeschichte unserer Superjunction CoolMOS-Technologie fort und untermauert die führende Stellung von Infineon im Bereich erstklassiger Leistungsumwandlung“, sagt Jan-Willem Reynaerts, Leiter des Produktbereichs High Voltage Power Conversion bei Infineon Technologies. „Mit der branchenweit führenden Figure of Merit ($R_{DS(on)} * E_{OSS}$) des CoolMOS C7 sind unsere Kunden in der Lage, eine neue Generation von Stromversorgungssystemen mit größerer Leistungsdichte und weiterer Effizienzsteigerung zu realisieren.“

C7 bietet den weltweit niedrigsten $R_{DS(on)}$ von 19mΩ in einem TO-247 Package bzw. 45mΩ in TO-220 und D²PAK-Gehäusen. Das schnelle Schaltverhalten von C7 ermöglicht es Kunden erstmals auch bei Schaltfrequenzen von über 100 kHz in Server-PFC-Stufen Wirkungsgrade auf Titanium-Level zu erreichen. Der geringere Platzbedarf der passiven Komponenten führt zu größerer Leistungsdichte.

Darüber hinaus führen die geringe Speicherladung im Ausgangskondensator (E_{OSS}) sowie eine niedrige Gate-Ladung Q_g zu einer Erhöhung des Wirkungsgrads auch bei geringer Last.

Die herausragenden Eigenschaften des C7 in Verbindung mit der fünften Generation der 650V thinQ!™ SiC Schottky-Dioden und den ICE2 / ICE3 Controllern von Infineon bieten Entwicklern die beste Leistung in CCM PFC-Schaltungen.

Verfügbarkeit

Muster der 650V CoolMOS C7-Produkte sind ab sofort verfügbar. Volumenstückzahlen sind verfügbar ab Juni 2013.

Weitere Informationen über die neue 650V CoolMOS C7-Familie gibt es unter www.infineon.com/c7

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2012 (Ende September) einen Umsatz von 3,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse.